

Procedeu de obținere a nanofirelor de arseniură de galiu, care include degresarea, spălarea în apă distilată, uscarea și scufundarea într-o soluție de HCl:H₂O cu un raport de 1:3 timp de 2 min a unei plachete de n-GaAs cu orientarea cristalografică (111)B, executarea unui contact electric din pastă de argint pe plachetă, instalarea plachetei pe un O-inel într-o celulă de Teflon și anodizarea acesteia într-un electrolit ce conține soluție de 1M HNO₃, la temperatura camerei timp de 20 min, în regim potențiostatic cu aplicarea tensiunii de 3,0...4,5 V.